



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

توصیف دینامیک فاصله ی کوچک (تله) رابط در ترانزیستور های آلی نازک لایه ، که مسئول ایجاد هیستریزیس میباشد

عنوان انگلیسی مقاله :

Characterization of interface trap dynamics responsible
for hysteresis in organic thin-film transistors



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

5. نتایج

5. Conclusion

In this paper, the gate-voltage sampling method is applied to extract both the trapping and detrapping rates. The detrapping process during the measurement is explained and the relevant equations are derived. The estimated trapping rate is around 30 s while the detrapping rate is about 0.5 s. To verify the validity of the technique, the channel charge pumping method is used. Since in the trapping and detrapping process the total trap densities measured using both methods are consistent with each other, giving a value close to $3.2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$, the accuracy of the technique is confirmed.

در این مقاله ، روش نمونه گیری ولتاژ گیت برای استخراج نرخ های حبس و آزاد سازی الکترون ها مورد استفاده قرار گرفت. روند رها سازی در طول اندازه گیری ها به طور کامل توضیح داده شده و معادلات مربوطه به دست آمده است. نرخ حبس تقریباً 30 s تخمین زده شد در حالی که نرخ رها سازی حدود 0.5 s تخمین زده شد. برای تایید اعتبار روش استفاده شده ، روش پمپ شارژ کانال نیز استفاده شده است. به این علت که در روند های حبس و آزاد سازی ، تراکم کلی تله ها در هر دو روش تقریباً با هم مطابقت داشت ، و هر دو مقداری نزدیک به $3.2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ را نتیجه دادند ، صحت تکنیک ها تایید میشود.



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.